

**【1000～2000万円】 Power Device Design Senior Engineer**

外資系デバイスメーカーでの募集です。電子デバイス研究開発のご経験のある方は歓迎...

## Job Information

**Recruiter**

JAC Recruitment Co., Ltd.

**Hiring Company**

外資系デバイスメーカー

**Job ID**

1487788

**Industry**

Communication

**Company Type**

International Company

**Job Type**

Permanent Full-time

**Location**

Osaka Prefecture

**Salary**

10 million yen ~ 20 million yen

**Work Hours**

09:00 ~ 18:00

**Holidays**

【有給休暇】有給休暇は入社後4ヶ月目から付与されます 初年度 14日 4か月目から 【休日】完全週休二日制 土日 夏季休暇 ...

**Refreshed**

January 31st, 2025 13:01

## General Requirements

**Career Level**

Mid Career

**Minimum English Level**

Business Level

**Minimum Japanese Level**

Native

**Minimum Education Level**

Bachelor's Degree

**Visa Status**

Permission to work in Japan required

## Job Description

【求人No NJB2224778】

・高性能パワーデバイス (SiC MOSFET/SBD, GaN HEMT, Si IGBT) のデザイン開発とテスト検証を担当し、プロセスチームと協力してデバイス加工とプロセスの最適化を行う。  
・高性能パワーデバイス (SiC MOSFET/SBD, GaN HEMT, Si IGBT) の個別技術をフォローアップし、既存のデバイスの性能を向上させ、パテントポートフォリオを提案して実現させる。

---

## Required Skills

### 必須要件

- ・半導体/電子/物理などの関連分野を専攻し、5年以上のパワーデバイスのデザイン開発経験（直近の3年間には関連のデザイン開発の従事が必須）、または優秀な博士課程の新卒者。
- ・パワーデバイス（SiC MOSFET/SBD、GaN HEMT、Si IGBT）の基本構造とデバイスシミュレーションデザイン方法に精通し、TCADソフトやレイアウトソフトを使用しデバイスデザインが得意な方。
- ・良好なコミュニケーション能力があり、異なる地域や異なる文化背景のチームと良好なコミュニケーションがとれる方。

---

## Company Description

ご紹介時にご案内いたします